

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

**特許第3774352号  
(P3774352)**

(45) 発行日 平成18年5月10日 (2006.5.10)

(24) 登録日 平成18年2月24日 (2006.2.24)

(51) Int. Cl.

F I

**G O 2 F 1/1368 (2006.01)**

G O 2 F 1/1368

**H O 1 L 29/786 (2006.01)**

H O 1 L 29/78 6 1 9 A

請求項の数 6 (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2000-45810 (P2000-45810)  
 (22) 出願日 平成12年2月23日 (2000.2.23)  
 (65) 公開番号 特開2001-235765 (P2001-235765A)  
 (43) 公開日 平成13年8月31日 (2001.8.31)  
 審査請求日 平成15年11月18日 (2003.11.18)

(73) 特許権者 000005108  
 株式会社日立製作所  
 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号  
 (74) 代理人 100084032  
 弁理士 三品 岩男  
 (72) 発明者 河内 玄士朗  
 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株  
 式会社日立製作所 日立研究所内

審査官 福島 浩司

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

少なくとも一方が透明な一对の基板と、この一对の基板に挟持された液晶層を有する液晶表示装置であって、

前記一对の基板の一方の基板は少なくともその主表面が絶縁性であって、

前記絶縁性の主表面に形成された複数の走査電極と、

前記複数の走査電極に交差するように形成された複数の信号電極と、

前記複数の信号電極と複数の走査電極の交差点近傍に形成された複数の薄膜トランジスタと、

前記複数の薄膜トランジスタの各々に接続され、前記複数の信号電極と絶縁層によって絶縁分離された画素電極とを有し、 10

前記画素電極に与える電圧によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置において、

前記画素電極と前記複数の信号電極とを絶縁分離する絶縁層は、前記複数の信号電極及び前記複数の薄膜トランジスタ上に形成された多孔質絶縁膜と、前記多孔質絶縁膜上に形成されたシリコン窒化膜またはシリコン酸化膜と、を有することを特徴とする液晶表示装置。

## 【請求項 2】

少なくとも一方が透明な一对の基板と、この一对の基板に挟持された液晶層を有する液晶表示装置であって、

前記一对の基板の一方の基板は少なくともその主表面が絶縁性であって、 20

前記絶縁性の主表面に形成された複数の走査電極と、  
前記複数の走査電極に交差するように形成された複数の信号電極と、  
前記複数の信号電極と複数の走査電極の交差点近傍に形成された複数の薄膜トランジスタと、

前記複数の薄膜トランジスタおよび複数の信号電極の上層に形成され、前記複数の薄膜トランジスタおよび複数の信号電極と絶縁層によって絶縁分離された透明な共通電極と、

前記薄膜トランジスタの各々に接続され、前記共通電極と第2の絶縁層によって絶縁分離された画素電極とを有し、

前記画素電極に与える電圧によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置において、前記複数の薄膜トランジスタおよび複数の信号電極と、前記共通電極とを絶縁分離する絶縁層は、前記複数の信号電極及び前記複数の薄膜トランジスタ上に形成された多孔質絶縁膜と、前記多孔質絶縁膜上に形成されたシリコン窒化膜またはシリコン酸化膜と、を有することを特徴とする液晶表示装置。

10

#### 【請求項3】

少なくとも一方が透明な一对の基板と、この一对の基板に挟持された液晶層を有する液晶表示装置であって、

前記一对の基板の一方の基板は少なくともその主表面が絶縁性であって、前記絶縁性の主表面に形成された複数の走査電極と、

前記複数の走査電極に交差するように形成された複数の信号電極と、

前記複数の信号電極と複数の走査電極の交差点近傍に形成された複数の薄膜トランジスタと、

20

前記薄膜トランジスタの各々に接続され、前記複数の信号電極と絶縁層によって絶縁分離された画素電極とからなるアクティブマトリクスを有し、

前記アクティブマトリクスに映像信号を供給する、前記一方の基板上に薄膜トランジスタを用いて構成した駆動回路をさらに有し、

前記画素電極に与える電圧によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置において、

前記駆動回路は、クロック信号により駆動されるシフトレジスタ回路と、映像信号をラッチするラッチ回路と、デジタル - アナログコンバータ回路と、ラインメモリと、前記ラインメモリに蓄えた映像信号を直結した前記信号電極に供給するためのアナログスイッチとを有し、

30

前記画素電極と前記複数の信号電極とを絶縁分離する絶縁層は、前記複数の信号電極及び前記複数の薄膜トランジスタ上に形成された多孔質絶縁膜と、前記多孔質絶縁膜上に形成されたシリコン窒化膜またはシリコン酸化膜と、を有することを特徴とする液晶表示装置。

#### 【請求項4】

請求項1～3のいずれか一項に記載の液晶表示装置において、

前記多孔質絶縁膜は主成分が酸化珪素であって、ポロジティが25%以上75%以下であることを特徴とする液晶表示装置。

#### 【請求項5】

請求項1～3のいずれか一項に記載の液晶表示装置において、

前記多孔質絶縁膜は主成分が酸化珪素であって、比誘電率が2.5以下であることを特徴とする液晶表示装置。

40

#### 【請求項6】

請求項1～3のいずれか一項に記載の液晶表示装置において、前記多孔質絶縁膜は主成分が酸化珪素であって、その密度が0.05 g / cm<sup>3</sup>以上0.3 g / cm<sup>3</sup>以下であることを特徴とする液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置に係り、特に、高精細高画質のTFTアクティブマトリックス方

50

式の液晶表示装置の構造に関する。

【 0 0 0 2 】

【 従来 の 技 術 】

ＯＡ機器等の画像情報、文字情報の表示装置として、薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴと記す）を用いたアクティブマトリックス方式の液晶表示装置が知られている。この種の液晶表示装置においては低コスト化、高精細化、高画質化が重要な課題である。

【 0 0 0 3 】

低コスト化のために、ＴＦＴアクティブマトリックスを駆動する周辺駆動回路をもＴＦＴで構成し、同一基板上に集積する回路内蔵技術の従来技術が特開平 8 - 1 6 7 7 2 2 号公報（第 1 の従来技術）に記載されている。駆動回路を内蔵することにより、外部接続のための接続端子の数を劇的に減らすことができるので、従来のように駆動ＬＳＩチップを実装する方式にくらべてより画素ピッチの微細な高精細の表示装置を安価に実現することが可能となる。

10

【 0 0 0 4 】

一方、画素ピッチが微細になってくると、画素開口率（単位画素内で光が透過する面積の比率）が減少し、光利用効率が低下するという問題が顕在化する。この問題を解決するためにさまざまな高開口率化技術が提案されている。その一つとして、特開平 9 - 2 2 0 2 8 号公報（第 2 の従来技術）には、液晶を駆動する画素電極と信号配線あるいは走査配線の間に感光性のレジストあるいはそのほかの有機膜を配置して画素電極と配線電極を重畳させることにより高開口率を得る方法が開示されている。

20

【 0 0 0 5 】

この従来技術は画素電極と配線電極を重畳させたときに形成される、画素電極と配線電極間の寄生容量を、誘電率 2 . 7 の有機膜を 2 ないし 3  $\mu\text{m}$  の厚みで形成することにより低減している。

【 0 0 0 6 】

【 発明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

上記第 2 の従来技術のように画素電極と配線電極を重畳させることは画素開口率を改善するためには非常に有効な手法であるが、一方、配線と画素電極間の間の寄生容量が大きくなるという欠点がある。特に、映像信号を供給する信号配線と画素電極間に大きな寄生容量が形成されると、信号のクロストークにより縦スミアと呼ばれる縦方向の画像のシャドウイングが発生し画質が低下する。上記第 2 の従来技術では画素電極と配線電極の間に形成する誘電体膜を、誘電率 2 . 7 の有機膜とし 2 ないし 3  $\mu\text{m}$  の厚みで形成することにより寄生容量を低減している。

30

【 0 0 0 7 】

しかしながら、上記の従来技術には以下のような問題がある。第 1 に耐熱性が無機膜にくらべ劣るレジストなどの有機膜の上に画素電極となるＩＴＯ電極を形成する際に、有機膜表面にしわが発生し、光透過率が低下することがある。これは有機膜の耐熱性が充分でないためにおこる。これを防止するため、有機膜の耐熱性を改善すると膜の誘電率が大きくなり、所望の寄生容量低減の効果が小さくなってしまう。

【 0 0 0 8 】

また、誘電率 2 . 7 という値は、寄生容量低減のためには充分小さい値ではなく、実際にはさらに小さな誘電率の膜が望まれるが、一般に有機材料では誘電率 2 . 5 以下となるような膜を得ることは困難であり、無理に誘電率を小さくすると耐熱性が低下し、上記のような問題が発生する。

40

【 0 0 0 9 】

さらに、上記第 2 の従来技術で形成される画素構造を有する液晶表示装置において、上記第 1 の従来技術のように、ＴＦＴで形成した周辺駆動回路を同一基板上に内蔵した場合、特に画質に与える影響が大きくなる。

【 0 0 1 0 】

ガラス基板上に集積する周辺駆動回路には多結晶シリコンを半導体活性層として用いたＴ

50

F Tが一般的に用いられるが、このような多結晶シリコンT F Tは、キャリア移動度が単結晶シリコンにくらべ劣ることや、駆動回路素子のゲート長やゲート酸化膜の膜厚をシリコンウエハを用いて製造されるドライバL S Iで用いられるトランジスタほど小さくすることは困難であることから、電流駆動能力が充分ではない。このため、ドライバL S Iを液晶パネルの外に設ける回路外付け型の液晶表示装置にくらべ、駆動回路内蔵型液晶表示装置では特に、駆動回路からみて負荷容量となる画素電極と配線電極間の寄生容量を小さくする必要がある。

#### 【0011】

このような目的のためには誘電率2.7という値は充分小さいとは言えず、さらに誘電率の小さな材料が必要となっている。

10

#### 【0012】

本発明の目的は、上述したような問題を解決し、画素電極と配線電極間の寄生容量を充分に低減できる構成を備えた液晶表示装置を提供することにある。

#### 【0013】

##### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明では、複数の信号電極と複数の走査電極が交差する点の近傍に形成された複数の薄膜トランジスタと、前記複数の薄膜トランジスタの各々に接続され前記複数の信号電極と絶縁層によって絶縁分離された画素電極とを有し、前記画素電極に与える電圧によって液晶層を駆動する液晶表示装置において、前記画素電極の一部と前記複数の信号電極の一部を重畳させ、前記画素電極と前記複数の信号電極とを絶縁分離する絶縁層を、少なくとも1層の酸化珪素を主成分とする多孔質絶縁膜を含むように構成したことを特徴とする。

20

#### 【0014】

##### 【発明の実施の形態】

本発明は、少なくとも一方が透明な一对の基板と、この基板に挟持された液晶層を有する液晶表示装置において、前記一对の基板の一方は少なくともその主表面が絶縁性であって、前記絶縁性の主表面に形成された複数の走査電極と、前記複数の走査電極に交差するように形成された複数の信号電極と、前記複数の信号電極と複数の走査電極が交差する点の近傍に形成された複数の薄膜トランジスタと、前記複数の薄膜トランジスタの各々に接続され前記複数の信号電極と絶縁層によって絶縁分離された画素電極とを有し、前記画素電極に与える電圧によって前記液晶層を駆動する機能をさらに有する液晶表示装置において、前記画素電極の一部と前記複数の信号電極の一部を重畳させ、前記画素電極と前記複数の信号電極とを絶縁分離する絶縁層を、少なくとも1層の酸化珪素を主成分とする多孔質絶縁膜を含むように構成したものである。

30

#### 【0015】

この時、前記多孔質絶縁膜は主成分が酸化珪素であって比誘電率が2.5以下であるか、あるいは、主成分が酸化珪素であってその密度が $0.05\text{ g/cm}^3$ 以上 $0.3\text{ g/cm}^3$ 以下とした。また、より望ましい構成として、前記画素電極と前記複数の信号電極とを絶縁分離する絶縁層は、少なくとも1層の酸化珪素膜または窒化珪素膜と多孔質絶縁膜からなる多層構造とした。さらにまた、前記多孔質絶縁膜は、主成分が酸化珪素であってポロジティが25%以上75%以下であることが好ましい。ここでポロジティとは膜中で空隙の体積割合を意味する。

40

#### 【0016】

本発明によれば、画素電極と信号配線電極間に介在する誘電体膜に酸化珪素を主成分とする多孔質膜絶縁膜を用いることにより、比誘電率を従来にくらべ飛躍的に低減できるため寄生容量を大幅に低減できる。特に、多孔質絶縁膜の密度を $0.05\text{ g/cm}^3$ 以上 $0.3\text{ g/cm}^3$ 以下とすることにより、比誘電率が2.5以下とできる。

#### 【0017】

さらに、本発明では、前記画素電極と前記複数の信号電極とを絶縁分離する絶縁層は、少なくとも1層の酸化珪素膜または窒化珪素膜と多孔質絶縁膜からなる多層構造とし、画素

50

電極となるITO電極と多孔質膜とが直接接触しないようにした。このような構成とすることにより、ITOをエッチングする際に、ITOのエッチング液である臭化水素酸などの強酸が多孔質膜中に侵入し、毛細管圧により多孔質膜を破壊する、あるいは、後の工程での汚染源となることを防止できる。

#### 【0018】

本発明のその他の特徴は以下の実施の形態から明らかとなるであろう。以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。

#### 【0019】

(実施の形態1)

図1および図2は本発明の第1の実施形態における液晶表示装置に係る単位画素の断面および平面図である。図1は図2中A-A'部の断面を示す。

10

#### 【0020】

本実施形態の液晶表示装置において、全体は歪点約670°Cの無アルカリガラス基板1上に膜厚50nmの $\text{Si}_3\text{N}_4$ 膜200と膜厚120nmの $\text{SiO}_2$ 膜2からなるバッファ絶縁膜23の上に形成されている。バッファ絶縁膜23はガラス基板1からのNa等の不純物の拡散を防止する役割を持つ。バッファ絶縁膜23上には膜厚50nmの真性多結晶Si(以下poly-Siと記す)膜30が形成され、真性poly-Si膜30は、一対の高抵抗N型poly-Si膜33に接し、さらに一対の高抵抗N型poly-Si膜33の各々はソース、ドレインとなる低抵抗N型poly-Si膜31に接している。高抵抗N型poly-Si膜33はLDD(Lightly Doped Drain)層として作用し、poly-Si層中ドレイン近傍の横方向電界を緩和し、ホットキャリアの発生を抑制する働きを持つ。真性poly-Si膜30上には $\text{SiO}_2$ からなるゲート絶縁膜20を介してMoよりなる走査配線電極10が形成されている。

20

#### 【0021】

さらに、本液晶表示装置においては、上記部材全部を覆うように $\text{SiO}_2$ からなる層間絶縁膜21が形成され、層間絶縁膜21に設けたコンタクトスルーホールを介して、Mo/Al/Moの3層金属膜よりなる信号配線電極12およびソース電極11が前記N型の低抵抗poly-Si層に接続されている。Alの下層のMo膜は低抵抗poly-Si膜とAlの間のコンタクト抵抗を、Alの上層のMo膜はソース電極と画素電極の間のコンタクト抵抗を低減するために設けている。また、多結晶シリコン膜の一部の上にはゲート絶縁膜20を介してMoよりなる共通電極15が形成され電荷蓄積容量Cstを構成している。本実施形態では、これらのTFEおよび容量素子全体は膜厚2 $\mu\text{m}$ の $\text{SiO}_2$ を主成分とする多孔質絶縁膜230により被覆されている。

30

#### 【0022】

さらに本液晶表示装置のTFEのソース電極11には、層間絶縁膜21および多孔質絶縁膜230に設けたコンタクトスルーホールを介してインジウム-スズ酸化物(ITO)よりなる画素電極13が接続されている。なお、図2に示すように、本実施形態の液晶表示装置においては、画素電極13の端部と信号配線電極12は互いに重畳するように配置されている。また、前記多孔質絶縁膜230は膜中の空隙の体積分率が約40%で比誘電率2.3を有するものである。

40

#### 【0023】

本実施形態によれば、画素電極13と信号配線電極12を絶縁層230を介して互いに重畳させることにより、開口率を向上できる。また、このように開口率が向上された構造において、信号配線電極12と画素電極13の間の絶縁膜230に、膜中の空隙の体積分率が約40%で比誘電率2.3の $\text{SiO}_2$ を主成分とする多孔質膜を用いることにより、信号配線電極12と画素電極13の間の寄生容量を効果的に低減できる。例えば、上記例の構成では、画素電極13と信号配線電極12間の単位長さあたりの寄生容量は約0.01fF/ $\mu\text{m}$ となり、画素ピッチを200 $\mu\text{m}$ とすると、1個の画素と1本の信号配線電極間の寄生容量値は約2fFと充分小さな値にできた。

#### 【0024】

50

(実施の形態2)

図3は本発明の第2の実施形態の液晶表示装置の単位画素の断面図である。本実施形態の平面パターンは図2に示されたものとほぼ同一であるため、ここでは図示しない。本実施形態においては、画素電極13と信号配線電極12を分離する絶縁層が $\text{SiO}_2$ を主成分とする多孔質絶縁膜230と $\text{Si}_3\text{N}_4$ からなる保護絶縁膜231の2層構造となっている点に特徴がある。

【0025】

本実施形態のようにITOからなる画素電極13と多孔質絶縁膜230の間に多孔質ではない通常の絶縁膜を挟むことにより、ITOの密着性が向上する。また、ITOのエッチング加工時に多孔質絶縁膜230がエッチング液に曝されることがないので、エッチング液による多孔質絶縁膜へのダメージ、具体的にはエッチング液が多孔質膜に浸透することで発生する毛管圧による膜の破壊を防止することができる。

10

【0026】

多孔質絶縁膜とITO電極との間の絶縁膜は $\text{Si}_3\text{N}_4$ に限らず、通常の $\text{SiO}_2$ 膜あるいは $\text{SiO}_x\text{N}_y$ 膜等でも同様な効果が得られる。

【0027】

(実施の形態3)

以上の2つの実施の形態では、多孔質絶縁膜は液晶表示装置の画素電極と信号配線電極の間を絶縁分離するために用いたが、多孔質絶縁膜が低誘電率であるという特徴は、液晶表示装置の信号配線電極と走査配線電極の間の絶縁膜に用いても生かすことができる。

20

【0028】

図4は本発明の第3の実施形態の液晶表示装置の単位画素の断面図である。本実施形態の平面パターンは図2に示されたものとほぼ同一である。本実施形態においては、走査配線電極10および共通電極15と信号配線電極12の間の層間絶縁膜として $\text{SiO}_2$ を主成分とする多孔質絶縁膜230を用いた点に特徴がある。

【0029】

本実施形態の構成によれば、信号配線電極12と走査配線電極10の間に形成される容量を低減できるため、駆動回路から見た負荷容量を小さくできる。このような低負荷容量化により駆動回路の消費電力を低減することが可能になる。この特徴は特にバックライトを用いない反射型液晶表示装置と組み合わせることにより、非常に低消費電力な液晶表示装置を構成するために有効である。

30

【0030】

(実施の形態4)

図5および図6は本発明の第4の実施の形態に係る液晶表示装置の単位画素の断面および平面図である。図5は図6中D-D'で示した線での断面図である。本実施の形態は逆スタガ型のTFTを駆動素子として用いた点に特徴がある。

【0031】

本実施形態では、歪点約 $670^\circ\text{C}$ の無アルカリガラス基板1上にCrよりなる走査電極配線10が形成され、これを覆うように $\text{Si}_3\text{N}_4$ からなるゲート絶縁膜24が形成されている。前記走査配線電極10上には前記ゲート絶縁膜24を介して、ほぼ真性の水素化非晶質シリコン300のパターンが形成され、前記ほぼ真性の水素化非晶質シリコン300上には一対のn型にドーパされた水素化非晶質シリコン310が形成されている。前記一対のn型にドーパされた水素化非晶質シリコン310にはそれぞれ、Mo、Al、Moの3層の積層膜よりなる信号配線電極12およびソース電極11が接触している。また、前記走査配線電極10の他の部分の上にはMo、Al、Moの3層の積層膜よりなる容量電極16がゲート絶縁膜24を介して形成され、蓄積容量を形成している。

40

【0032】

さらに本実施形態では、TFTと容量素子全体を被覆するように、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ よりなる保護絶縁膜231が形成され、さらに保護絶縁膜231上には $\text{SiO}_2$ を主成分とする多孔質絶縁膜230が形成されている。前記多孔質絶縁膜230上にはITOからなる画素電極

50

13が、その端部が前記信号配線電極12と重畳するように形成され、保護絶縁膜231および多孔質絶縁膜230に開口したスルーホールを介してTFTのソース電極11と容量電極16に接続されている。

#### 【0033】

本実施形態では、画素電極13と前記信号配線電極12と重畳させつつ前記第1の実施形態と同様に画素電極13と信号配線電極12間の寄生容量を低減できるので、開口率が大きくかつクロストークがない良好な画質を持つ液晶表示装置を実現できる。

#### 【0034】

また、本実施形態では逆スタガ型のTFTを用いているが、逆スタガ型のTFTでは1対のn型水素化非晶質シリコン膜の間に形成される真性水素化非晶質シリコン膜面と保護絶縁膜との界面（バックチャネルと称する）性質がTFTのオフ特性に強い影響をおよぼす。このため、多孔質絶縁膜のような水分等を吸着しやすい物質をTFT上に直接形成することは望ましくない。このため本実施形態では多孔質膜とTFTの間に $\text{Si}_3\text{N}_4$ からなる保護絶縁膜231を設けた。このことにより、オフ電流が小さく安定なTFTを形成できるので良好な画質を持つ液晶表示装置を実現できる。

#### 【0035】

（実施の形態5）

図7および図8は本発明の第5の実施の形態に係る液晶表示装置の単位画素の断面および平面図である。図7は図8中E-E'で示した線での断面図である。

#### 【0036】

本実施形態の液晶表示装置において、全体は歪点約 $670^\circ\text{C}$ の無アルカリガラス基板1上に膜厚50nmの $\text{Si}_3\text{N}_4$ 膜200と膜厚120nmの $\text{SiO}_2$ 膜2からなるバッファ絶縁膜の上に形成されている。バッファ絶縁膜上には膜厚50nmの真性多結晶Si（以下poly-Siと記す）膜30が形成され、真性poly-Si膜30は、一対の高抵抗N型poly-Si膜33に接し、さらに一対の高抵抗N型poly-Si膜33のおのおのはソース、ドレインとなる低抵抗N型poly-Si膜31に接している。真性poly-Si膜30上には $\text{SiO}_2$ からなるゲート絶縁膜20を介してMoよりなる走査配線電極10が形成されている。

#### 【0037】

さらに本実施形態では、上記部材全部を覆うように $\text{SiO}_2$ からなる層間絶縁膜21が形成され、層間絶縁膜21に設けたコンタクトスルーホールを介して、Mo/Al/Moの3層金属膜よりなる信号配線電極12およびソース電極11が前記N型の低抵抗poly-Si層に接続されている。TFT全体は膜厚2 $\mu\text{m}$ の $\text{SiO}_2$ を主成分とする多孔質絶縁膜230と膜厚50nmの $\text{Si}_3\text{N}_4$ よりなる保護絶縁膜231により被覆されている。

#### 【0038】

保護絶縁膜231上にはコンタクト部分THを除く画像表示部のほぼ全面に渡ってITOよりなる共通電極17が形成されている。前記共通電極17上には膜厚300nmの $\text{SiO}_2$ よりなる容量絶縁膜25が形成され、前記容量絶縁膜25上にはITOよりなる画素電極13がその端部が前記信号配線電極12と重畳するように形成されている。前記容量絶縁膜25、保護絶縁膜231、多孔質絶縁膜230に設けたスルーホールを介してTFTのソース電極11に接続され、前記共通電極17と容量絶縁膜25と画素電極13により蓄積容量を形成している。

#### 【0039】

本実施形態においては、画素電極13と信号配線電極12とを重畳させただけでなく、蓄積容量を2層のITO電極とその間に挟持された絶縁層により構成したため、容量形成に伴う開口率の低下がなく、開口率を極めて大きくできる。本実施形態によれば、画素ピッチ200 $\mu\text{m}$ で開口率85%が得られた。

#### 【0040】

通常、共通電極17を表示部のほぼ全面に渡って形成すると、共通電極と走査配線電極10あるいは信号配線電極間12の容量が増大し、共通電極17の容量負荷が大きくなり、

10

20

30

40

50

横スミアと呼ばれる画像が横方向へのシャドウイングが発生することが知られている。本実施形態では、この問題を解決するため、信号配線電極 1 2 と共通電極 1 7 の間に  $\text{SiO}_2$  を主成分とする多孔質絶縁膜を配置することにより、共通電極と配線の間に形成される寄生容量を低減できた、このことにより、画質の低下を伴うことなく開口率を拡大できたので、高画質で明るい液晶表示装置を実現できた。

#### 【0041】

さらに、本実施形態の構成によれば、蓄積容量値を大きくしても開口率の低下がないため、容量値を大きくすることができる、これにより TFT のリーク電流を補償できるので、リーク電流に起因するコントラスト低下や画像の焼きつき等の画質不良を抑制できる。この特徴は TFT の特性ばらつきが比較的大きいレーザ再結晶化法により形成した多結晶シリコン膜上に形成した TFT を用いる液晶表示装置において、オフ電流ばらつきのマージンを拡大することを意味しより望ましいものである。

10

#### 【0042】

(実施の形態 6)

図 9 および図 10 は本発明の第 6 の実施形態にかかる液晶表示装置の単位画素の平断面および平面図である。図 9 は図 10 中、F - F' で示した線に沿った断面図である。

#### 【0043】

本実施形態の構成は、前記第 5 の実施形態とほぼ同様である。すなわち、TFT 上に膜厚  $2\mu\text{m}$  の  $\text{SiO}_2$  を主成分とする多孔質絶縁膜 230 と膜厚  $50\text{nm}$  の  $\text{Si}_3\text{N}_4$  よりなる保護絶縁膜 231 を形成し、保護絶縁膜 231 上にはコンタクト部分 TH を除く画像表示部のほぼ全面に渡って ITO よりなる共通電極 17 が形成され、前記共通電極 17 上には膜厚  $300\text{nm}$  の  $\text{SiO}_2$  よりなる容量絶縁膜 25 が形成され、前記容量絶縁膜 25 上には ITO よりなる画素電極 13 がその端部が前記信号配線電極 12 と重畳するように形成され、前記容量絶縁膜 25、保護絶縁膜 231、多孔質絶縁膜 230 に設けたスルーホールを介して TFT のソース電極 11 に接続され、前記共通電極 17 と容量絶縁膜 25 と画素電極 13 により蓄積容量を形成している。

20

#### 【0044】

これらの特徴的構成により、本実施形態においては、前記第 5 の実施の形態と同等な効果を持つ。加えて、本実施形態においては、容量絶縁膜 25 上に形成される画素電極 13 が櫛歯状の平面パターンを有し、この櫛歯状画素電極の隙間と、容量絶縁膜下の共通電極間に液晶層を駆動する電圧を与え、これらの電極の間に発生するフリンジ電界により液晶層を駆動することを特徴とする。

30

#### 【0045】

本実施形態のように、液晶層を基板面にほぼ沿う方向の電界により駆動すると、電界を印加したさいに液晶分子が基板面に対して立ちあがらないで、基板面内で回転することにより透過する光の偏光方向を制御して画像表示ができるので、液晶分子の複屈折性に起因するコントラストの視野角依存性を実質的になくすることができ、視野角の広い高画質の液晶表示装置が得られる。

#### 【0046】

(実施の形態 7)

40

図 11 は、周辺駆動回路を TFT アクティブマトリックスとともに同一基板上に集積した、本実施形態による液晶表示装置全体の等価回路を示す。例えば、図 3 および図 4 に示した実施形態の構成を持ち、Y1 ~ Yend の走査配線電極 10 と X1R、X1G、X1B ~ XendB の信号配線電極 12、および、画素毎に設けられた TFT とならなる TFT アクティブマトリックス 50 と、これを駆動する垂直走査回路 51、水平走査回路 52 よりなる。

#### 【0047】

垂直走査回路 51 は、クロック信号 CLKV により駆動されるシフトレジスタ回路 SRV と、行選択電圧 VG を供給されるレベルシフタ DRV とからなり、走査配線電極 10 に行選択パルスを出力する。

50

## 【 0 0 4 8 】

水平走査回路 5 2 は、クロック信号 C L K H により駆動されるシフトレジスタ回路 S R H と、6 ビットにデジタル化された画像データ D A T A をラッチするためのラッチ回路 L 1、ラッチされたデジタルデータをアナログデータにデコードするデジタルーアナログコンバータ回路 D A C、1 行分の D A C からの出力を一時的に蓄えるラインメモリ L M、およびラインメモリ L M に蓄えた画像データを信号配線電極 1 2 に供給するためのアナログスイッチ S W よりなる。尚、D A C には各ビットに対応して重み付けされた基準電圧信号が供給されている。

## 【 0 0 4 9 】

T F T アクティブマトリクス 5 0 として、本発明の構造を用いたことにより、画素電極と信号配線電極 1 2 の間の寄生容量を小さくできる。このことは水平走査回路 5 2 からみると出力トランジスタが駆動すべき負荷容量が小さくなったことを意味し、出力トランジスタの駆動能力がさほど小さくなくても、信号配線電極 1 2 を駆動可能になる。

## 【 0 0 5 0 】

通常、単結晶シリコンの用いた液晶駆動用 L S I においては、出力段の駆動能力を大きくするためアナログスイッチの後段にアナログアンプを形成している。このアナログアンプの出力電圧はペアリングされたトランジスタの特性が一致しないとオフセットを持ち、これが出力端子毎にばらつくと、表示むらになることがしばしば問題になる。このような問題は、本実施形態のような多結晶シリコン T F T でも同様である。ただし、多結晶シリコン T F T における個々の T F T のばらつきは、単結晶のそれとは比べものにならないくらい大きいので、出力電圧のばらつきを抑えたアナログアンプを構成することは、実際には非常に困難である。

## 【 0 0 5 1 】

よって、多結晶シリコン T F T により駆動回路を構成する場合、アナログアンプを出力段に入れないよう構成することが一つの解決法となりうる。しかし、このような場合、回路の電流駆動能力をあまり大きくできないので、負荷容量の方を大幅に削減することが必要となる。そこで、本発明の構成によれば、信号配線電極の容量を低減することが可能となるため、このような表示むらの原因となるアナログアンプを敢えて使用しなくても駆動を可能とする。したがって、本実施形態の構成は、多結晶シリコン T F T で構成した駆動回路内蔵型の液晶表示装置に好適なものである。

## 【 0 0 5 2 】

( 実施の形態 8 )

図 1 2 は本発明に係る液晶表示装置の液晶セル断面構造の一例を示す模式図である。液晶層 5 0 6 を基準に下部のガラス基板 1 上には、走査配線電極 1 0 と信号配線電極 1 2 とがマトリクス状に形成され、その交点近傍に形成された T F T を介して I T O よりなる画素電極 1 3 を駆動する。液晶層 5 0 6 を挟んで対向する対向ガラス基板 5 0 8 上には I T O よりなる対向電極 5 1 0、及びカラーフィルター 5 0 7、カラーフィルター保護膜 5 1 1、遮光用ブラックマトリクスパターンを形成する遮光膜 5 1 2 が形成されている。

## 【 0 0 5 3 】

偏光板 5 0 5 はそれぞれ一对のガラス基板 1、5 0 8 の外側の表面に形成されている。液晶層 5 0 6 は液晶分子の向きを設定する下部配向膜 O R I 1 と、上部配向膜 O R I 2 の間に封入され、シール材 S L ( 図示せず ) によってシールされている。下部配向膜 O R I 1 は、ガラス基板 1 側の多孔質絶縁膜 2 3 0 の上部に形成される。対向ガラス基板 5 0 8 の内側の表面には、遮光膜 5 1 2、カラーフィルター 5 0 7、カラーフィルター保護膜 5 1 1、対向電極 5 1 0 および上部配向膜 O R I 2 が順次積層して設けられている。

## 【 0 0 5 4 】

本液晶表示装置はガラス基板 1 側と対向ガラス基板 5 0 8 側の層を別々に形成し、その後上下ガラス基板 1、5 0 8 を重ねあわせ、両者間に液晶 5 0 6 を封入することによって組立られる。バックライト B L からの光の透過を画素電極 1 4 部分で調節することにより T F T 駆動型のカラー液晶表示装置が構成される。以上に述べた本発明の構成を用いること

10

20

30

40

50

により高画質のＴＦＴ方式透過型液晶表示装置を実現できる。

【００５５】

また、本発明の素子構造は透過型液晶表示装置だけでなく、反射型液晶表示装置にも適用可能である。例えば、図１１において、画素電極１３にＩＴＯではなく、Ａ１のような反射率の高い金属電極を用い、ガラス基板１下部の偏光板５０５とバックライトＢＬを除くことにより、本発明を適用した反射型の液晶表示装置が実現できる。

【００５６】

（実施の形態９）

本発明に係る製造工程を、上記図４に示した実施形態を例に取り、以下図１３～図１９を用いて説明する。

10

【００５７】

本例の製造工程においては最初に、厚さ７００μｍ、幅７５０ｍｍ、幅９５０ｍｍの歪点約６７０℃の無アルカリガラス基板１上を洗浄後、 $\text{SiH}_4$ と $\text{NH}_3$ と $\text{N}_2$ の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法により、膜厚５０ｎｍの $\text{Si}_3\text{N}_4$ 膜２００を形成する。形成温度は３５０℃である。続いて、テトラエトキシシランと $\text{O}_2$ の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法により、膜厚１２０ｎｍの $\text{SiO}_2$ 膜１００を形成する。 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、 $\text{SiO}_2$ ともに形成温度は３５０℃である。

【００５８】

次に、 $\text{SiO}_2$ 膜１００上に $\text{SiH}_4$ 、 $\text{Ar}$ の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法によりほぼ真性の水素化非晶質シリコン膜３００を５０ｎｍ形成する。成膜温度は３８０℃で、成膜直後水素量は約５ａｔ％であった。さらに基板を４５０℃で約３０分アニールすることにより、水素化非晶質シリコン膜３００中の水素を放出させる。アニール後の水素量は約１ａｔ％であった（図１３）。

20

【００５９】

次に、基板を３５０℃に保持しながら、波長３０８ｎｍのエキシマレーザー光ＬＡを前記非晶質シリコン膜にフルエンス４００ $\text{mJ}/\text{cm}^2$ で照射し、非晶質シリコン膜を熔融再結晶化させて、ほぼ真性の多結晶シリコン膜３０を得る（図１４）。

【００６０】

次に、通常のホテルソグラフィ法により所定のレジストパターンを多結晶シリコン膜３０上に形成し $\text{CF}_4$ と $\text{O}_2$ の混合ガスを用いたリアクティブイオンエッチング法により多結晶シリコン膜３０を所定の形状に加工する。

30

【００６１】

次に、テトラエトキシシランと酸素の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法により膜厚１００ｎｍの $\text{SiO}_2$ を形成しゲート絶縁膜２０を得る。この時のテトラエトキシシランと $\text{O}_2$ の混合比は１：５０、形成温度は３８０℃である。

【００６２】

次にスパッタリング法により、 $\text{Mo}$ 膜を２００ｎｍ形成後、通常のホテルソグラフィ法により所定のレジストパターンを $\text{Mo}$ 膜上に形成し、 $\text{CF}_4$ と $\text{O}_2$ の混合ガスを用いたリアクティブイオンエッチング法により $\text{Mo}$ 膜を所定の形状に加工し走査配線電極１０を得る（図１５）。

40

【００６３】

次に、イオン注入法によりＰイオンを加速電圧７０ＫｅＶ、ドーズ量１ $\text{E}13(\text{cm}^{-2})$ で打ちこんだあと、所定のレジストパターンを形成後にイオン注入法によりＰイオンを加速電圧７０ＫｅＶ、ドーズ量１ $\text{E}15(\text{cm}^{-2})$ で打ちこみＮ型ＴＦＴのソース、ドレイン領域３１およびＬＤＤ領域３３を形成する（図１６）。

【００６４】

次に、所定のレジストパターンを形成後、イオン注入法によりＢイオンを加速電圧４０ＫｅＶ、ドーズ量１ $\text{E}15$ で打ちこみ、Ｐ型ＴＦＴ（図示せず）のソース、ドレイン領域を形成する。

【００６５】

50

次に、テトラエトキシシランと酸素の混合ガスを用いたプラズマCVD法により、膜厚500nmの $\text{SiO}_2$ を形成し層間絶縁膜21を得る。この時のテトラエトキシシランと $\text{O}_2$ の混合比は1:5、形成温度は350°Cである。

#### 【0066】

次に、基板を550°Cで5分間アニールして注入したPやBの不純物を活性化し、TFTのソース、ドレインおよびLDD領域の抵抗を所定の値にする。不純物活性化法としては通常の熱処理以外にランプを用いたラピッドサーマルアニール(RTA)法を使用することも可能である。

#### 【0067】

次に、所定のレジストパターンを形成後、 $\text{CHF}_3$ を用いたリアクティブイオンエッチング法により、前記層間絶縁膜にコンタクトスルーホールを開孔する。続いて、スパッタリング法により、Moを50nm、Al-Si合金を500nm、Moを50nmと順次積層形成した後、所定のレジストパターンを形成後、 $\text{BCl}_3$ と $\text{Cl}_2$ の混合ガスを用いたリアクティブイオンエッチング法により一括エッチングし、信号配線電極12とソース電極11を得る(図17)。

10

#### 【0068】

次に、シリカ微粒子を分散した液体のトリエトキシシランをスピンコート法により基板の上にコートし、膜厚約2.5 $\mu\text{m}$ のスピンオングラス(SOG)膜を形成し、これを300°Cで10分間ベークすることにより、膜厚2 $\mu\text{m}$ の多孔質の $\text{SiO}_2$ 膜230を形成した。多孔質膜230の比誘電率は約2.3である(図18)。

20

#### 【0069】

多孔質膜のシリカ膜の形成は、この他、例えばジフェニルジメチルシラン( $\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2(\text{OCH}_3)_2$ )とArの混合ガスを用いたプラズマCVD法により温度150°Cで $\text{SiO}_2$ 膜を形成後、400°Cで $\text{O}_2$ プラズマ処理を行うことによっても得られる。ただし、 $\text{O}_2$ プラズマ処理後は膜が吸湿性を帯びるのでヘキサメチルジシラザン(HMDS)処理を250°Cで15分行うことにより吸湿のない安定した多孔質シリカ膜をえることができた。

#### 【0070】

この他にも、テトラエトキシシランをアルカリ触媒により湿潤ゲル化して基板の上に塗布し、テトラエトキシシランの加水分解によって生成された膜中の $\text{H}_2\text{O}$ をエタノールで置換処理したあと、 $\text{CO}_2$ 等を用いた超臨界流体乾燥法により膜中のエタノールを除去することでも多孔質膜を得ることができる。但し、 $\text{CO}_2$ を用いた超臨界流体処理は超高压容器を必要とするため、1m近い大きさを持つ液晶表示装置用ガラス基板を処理するにはあまり適当ではない。塗布法あるいはドライプロセスで形成することが望ましい。

30

#### 【0071】

なお、本発明においては多孔質絶縁膜の形成方法は上記の例だけに限定されるものではなく、上述したような比誘電率の多孔質絶縁膜が形成されるのであれば、他の形成方法を用いてもよい。

#### 【0072】

最後に、 $\text{SiH}_4$ と $\text{NH}_3$ と $\text{N}_2$ の混合ガスを用いたプラズマCVD法により膜厚50nmの $\text{Si}_3\text{N}_4$ 膜231を形成した後、所定のレジストパターンを $\text{Si}_3\text{N}_4$ 膜上に形成し、 $\text{CF}_4$ を用いたリアクティブイオンエッチング法により、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 膜231および多孔質シリカ膜230にコンタクトスルーホールを形成し、続いてスパッタリング法によりITO膜を140nm形成し、臭化水素酸( $\text{HBr}$ )を用いて所定の形状に加工してアクティブマトリクス基板が完成する(図19)。

40

#### 【0073】

#### 【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、画素電極と信号電極配線間の寄生容量を低減することができるため、寄生容量の増大を伴うことなしに開口率を向上できるので、明るい、高画質の液晶表示装置を実現できる。

50

## 【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素断面図。

【図 2】本発明の第 1 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素平面図。

【図 3】本発明の第 2 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素断面図。

【図 4】本発明の第 3 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素断面図。

【図 5】本発明の第 4 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素断面図。

【図 6】本発明の第 4 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素平面図。

【図 7】本発明の第 5 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素断面図。

【図 8】本発明の第 5 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素平面図。

【図 9】本発明の第 6 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素断面図。

10

【図 10】本発明の第 6 の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素平面図。

【図 11】本発明の第 7 の実施の形態にかかる駆動回路内蔵型液晶表示装置の全体構成図

。

【図 12】本発明の第 8 の実施の形態にかかる液晶表示装置のセル断面図。

【図 13】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

【図 14】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

【図 15】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

【図 16】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

【図 17】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

【図 18】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

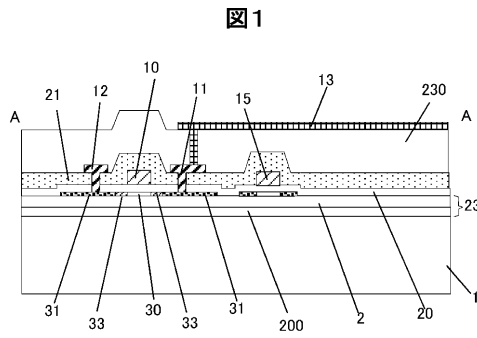
20

【図 19】本発明の第 2 の実施形態の液晶表示装置の一製造工程を示す断面図。

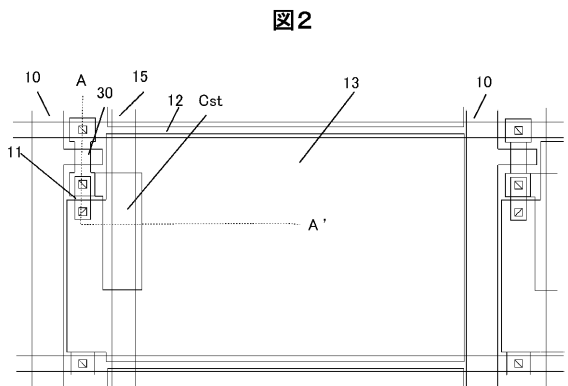
## 【符号の説明】

1 ... ガラス基板、2 ...  $\text{Si}_3\text{N}_4$  バッファ膜、10 ... 走査配線電極、11 ... ソース電極、  
12 ... 信号配線電極、13 ... 画素電極、15 ... 容量電極、17 ... 共通電極、20 ... ゲート  
絶縁膜、21 ... 層間絶縁層、23 ... 保護絶縁膜、24 ...  $\text{Si}_3\text{N}_4$  膜（ゲート絶縁膜）、2  
5 ... 容量絶縁膜、30 ... 真性  $\text{poly-Si}$  膜、31 ... 低抵抗  $n$  型  $\text{poly-Si}$  層、3  
3 ... 高抵抗  $n$  型  $\text{poly-Si}$  層、50 ... TFT アクティブマトリクス、51 ... 垂直走査  
回路、52 ... 水平走査回路、200 ...  $\text{SiO}_2$  バッファ膜、230 ... 多孔質絶縁膜、23  
1 ... 保護絶縁膜、300 ... 真性水素化非晶質  $\text{Si}$  膜、Cst ... 蓄積容量。

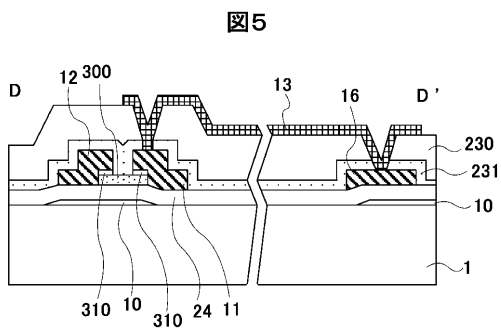
【 図 1 】



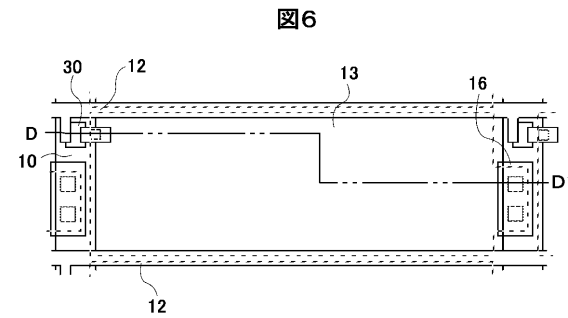
【 図 2 】



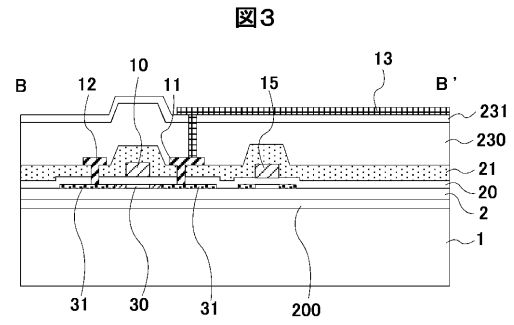
【 図 5 】



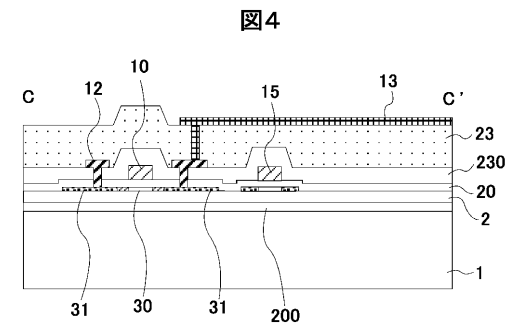
【 図 6 】



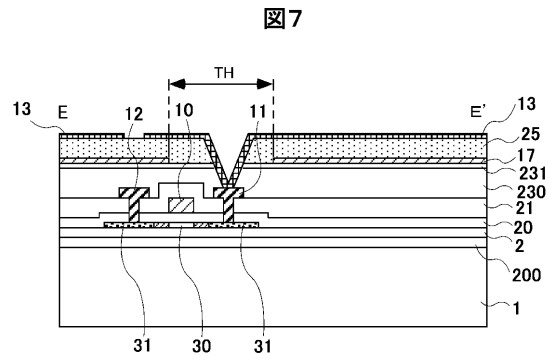
【 図 3 】



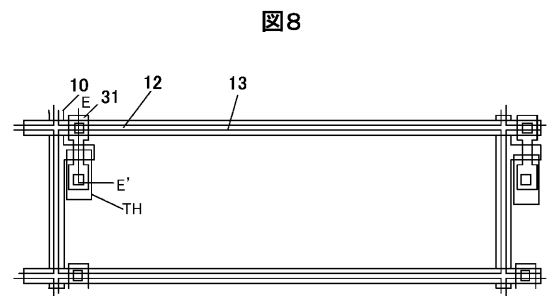
【 図 4 】



【圖 7】



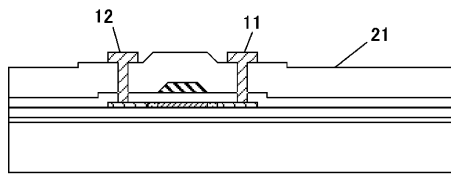
【圖 8】





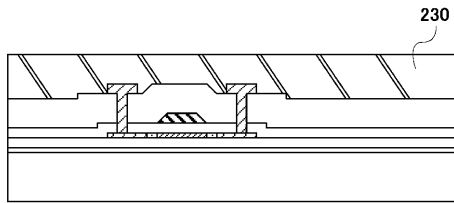
【図 17】

図17



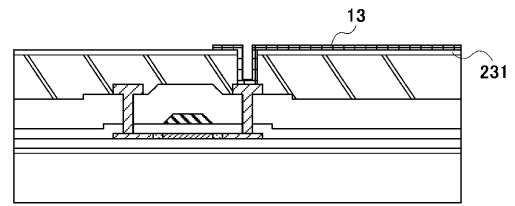
【図 18】

図18



【図 19】

図19



---

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平 1 1 - 0 5 0 0 0 7 ( J P , A )  
特開平 1 1 - 0 5 2 3 4 4 ( J P , A )  
特開平 0 8 - 3 3 0 3 0 0 ( J P , A )  
特開平 1 1 - 3 1 6 3 8 3 ( J P , A )  
特開平 1 0 - 1 9 7 8 9 7 ( J P , A )

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G02F 1/1368

H01L 29/786

